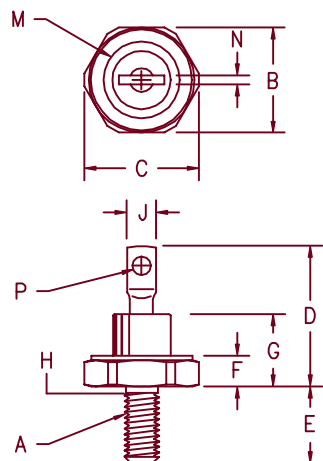


# Military Silicon Power Rectifier

## 1N1202A–1N1206A, 1N3671A–1N3673A



### Notes:

1. 10–32 UNF3A
2. Full threads within 2 1/2 threads
3. Standard Polarity: Stud is Cathode  
Reverse Polarity: Stud is Anode

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	---	---	---	---	1
B	.424	.437	10.77	11.10	
C	---	.505	---	12.83	
D	---	.800	---	20.32	
E	.422	.453	10.72	11.51	
F	.075	.175	1.91	4.44	
G	---	.405	---	10.29	
H	.163	.189	4.15	4.80	2
J	.100	.140	2.54	3.56	
M	---	.350	---	8.89	Dia
N	.020	.065	.510	1.65	
P	.070	.100	1.78	2.54	Dia

### D0203AA (D04)

- Available in JAN, JANTX and JANTXV
- MIL-PRF-19500/260
- Glass passivated die
- Glass to metal seal construction
- 240 Amps surge rating
- $V_{RRM}$  to 1000 volts

### Microsemi Catalog Number

### Peak Reverse Voltage

Standard	Reverse	Peak Reverse Voltage
1N1202A	1N1202RA	200V
1N1204A	1N1204RA	400V
1N1206A	1N1206RA	600V
1N3671A	1N3671RA	800V
1N3673A	1N3673RA	1000V

### Electrical Characteristics

Average forward current	$I_{F(AV)}$ 12 Amps	$T_C = 150^\circ\text{C}$ , half sine wave, $R_{\theta JC} = 2.0^\circ\text{C/W}$
Maximum surge current	$I_{FSM}$ 240 Amps	8.3ms, half sine, $T_C = 200^\circ\text{C}$
Max $I^2t$ for fusing	$I^2t$ 240 A <sup>2</sup> s	
Max peak forward voltage	$V_{FM}$ 1.35 Volts	$I_{FM} = 38\text{A}; T_J = 25^\circ\text{C}^*$
Max peak reverse current	$V_{FM}$ 2.30 Volts	$I_{FM} = 240\text{A}; T_J = 25^\circ\text{C}$
Max peak reverse current	$I_{RM}$ 5 $\mu\text{A}$	$V_{RRM}, T_J = 25^\circ\text{C}$
Max peak reverse current	$I_{RM}$ 1.0 mA	$V_{RRM}, T_J = 150^\circ\text{C}$
Max Recommended Operating Frequency	10kHz	

\*Pulse test: Pulse width 300  $\mu\text{sec}$ . Duty cycle 2%

### Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temperature range	$T_{STG}$	$-65^\circ\text{C}$ to $200^\circ\text{C}$
Operating case temp range	$T_C$	$-65^\circ\text{C}$ to $150^\circ\text{C}$
Maximum thermal resistance	$R_{\theta JC}$	$2.0^\circ\text{C/W}$ Junction to Case
Mounting torque		15 inch pounds maximum
Weight		.16 ounces (5.0 grams) typical

11–27–00 Rev. 1

# MILITARY

## 1N1202A-1N1206A, 1N3671A-1N3673A

Figure 1  
Typical Forward Characteristics

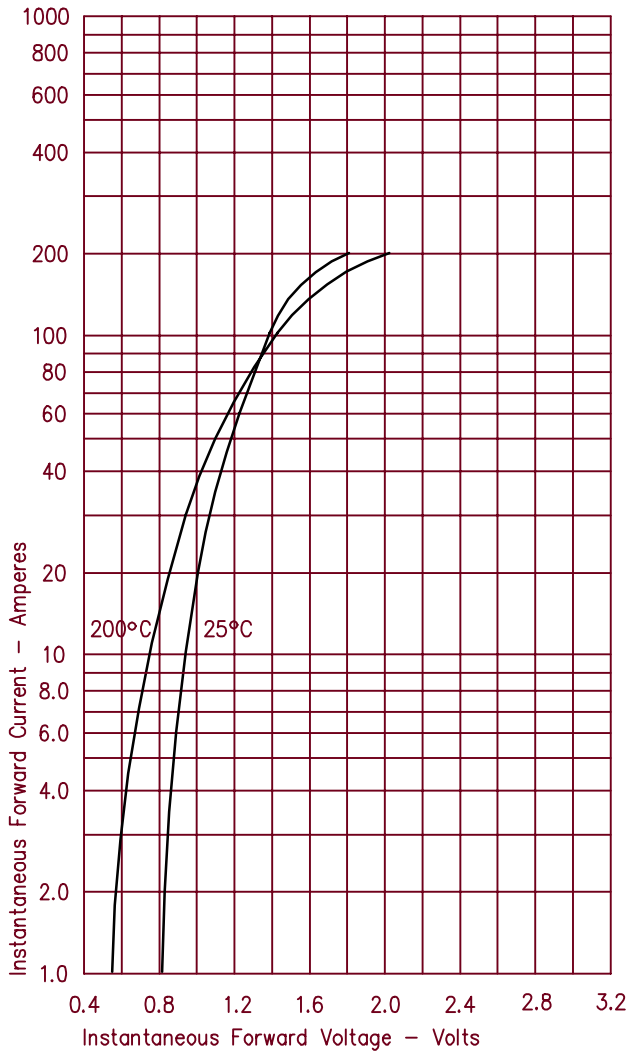


Figure 3  
Forward Current Derating

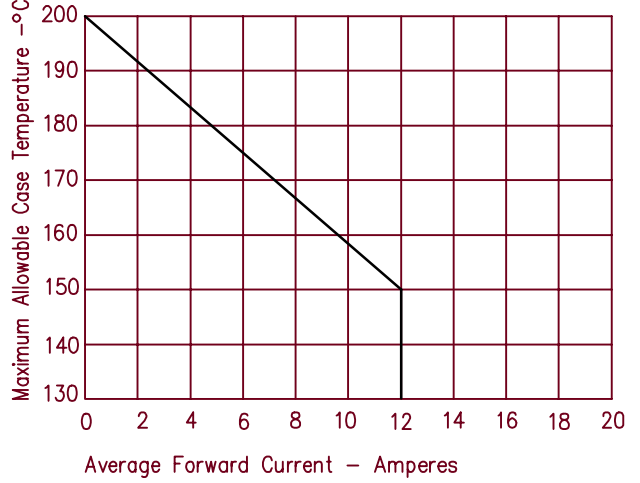


Figure 5  
Transient Thermal Impedance

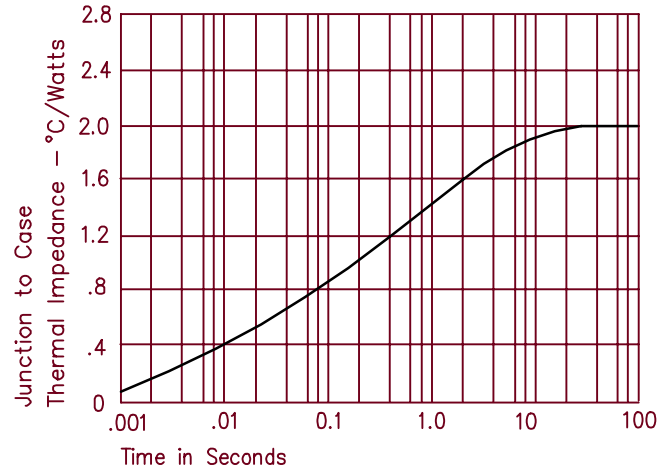
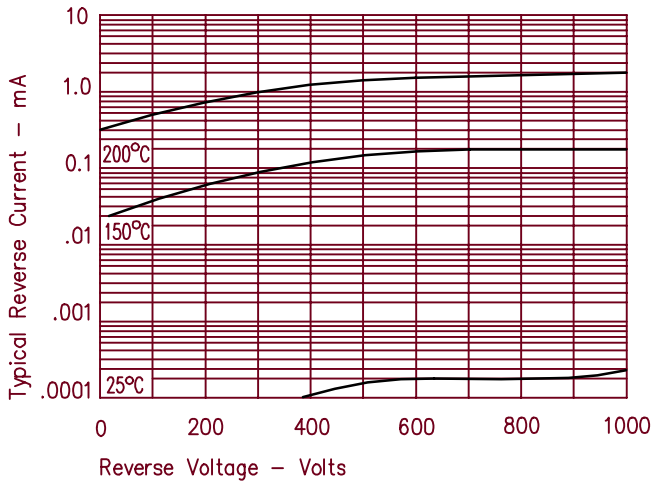


Figure 2  
Typical Reverse Characteristics





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.